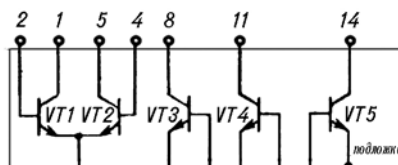


КР198НТ10

Микросхема представляет собой матрицу *n-p-n*-транзисторов. Содержит 5 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ10

Назначение выводов

1	коллектор VT1
2	база VT1
3	эмиттеры VT1 и VT2
4	база VT2
5	коллектор VT2
6	база VT3
7	эмиттер VT3
8	коллектор VT3
9	база VT4
10	эмиттер VT4
11	коллектор VT4
12	база VT5
13	эмиттер VT5 (подложка)
14	коллектор VT5

Вывод 13 соединяется с наиболее отрицательным потенциалом схемы (для обеспечения нормальной работы транзисторов).

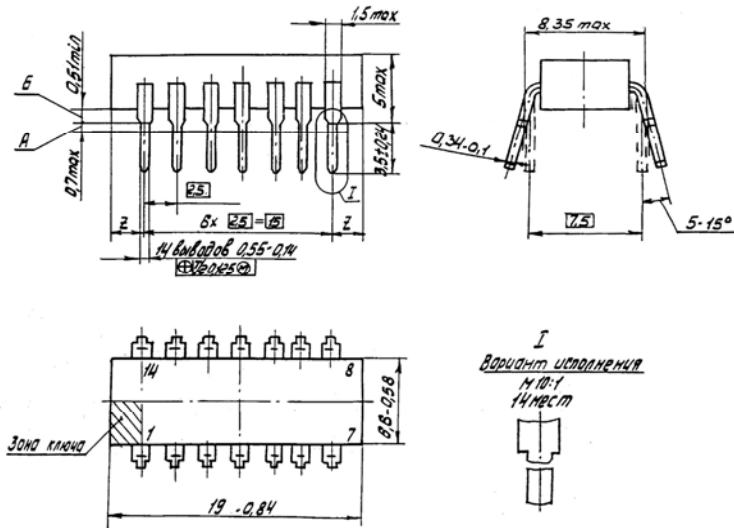
Электрические параметры

Напряжение насыщения база-эмиттер.....	≤1 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер.....	≤0,7В
Напряжение смещения нуля.....	≤4 мВ
Обратный ток коллектора.....	≤40 нА
Статический коэффициент передачи тока.....	60... 150
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары.....	≤15%

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-база.....	20 В
Напряжение эмиттер-база.....	5 В
Ток коллектора.....	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором.....	20 мВт
Температура окружающей среды.....	-45...+85°C

Чертеж корпуса
Пластмассовый корпус типа 201.14-1



1. А- длина выводов, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б- ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для контакта. Допускаются капли стекла по выводам за пределы наружного контура корпуса микросхемы не более 0,5 мм на сторону.
3. Допускаются заусенцы высотой 0,04 max, сверх размера 0,18 - 0,07
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Дно металлическое.